



(51) Classification internationale des brevets :
H01L 21/62 (2006.01)

(21) Numéro de la demande internationale :
PCT/FR2014/050666

(22) Date de dépôt international :
21 mars 2014 (21.03.2014)

(25) Langue de dépôt : français

(26) Langue de publication : français

(30) Données relatives à la priorité :
1300738 29 mars 2013 (29.03.2013) FR

(71) Déposant : SOITEC [FR/FR]; Chemin des Franques, F-38190 Bernin (FR).

(72) Inventeurs : KERDILES, Sébastien; 304 Allée des Jardins de Buttât, F-38330 Saint Ismier (FR). CHABANNE, Guillaume; 5 Le Clos des Prés, Boulevard Langevin, F-38190 Froges (FR). BOEDT, François; 3 Allée des Frênes, F-38240 Meylan (FR).

(74) Mandataire : BREESE, Pierre; Fidal Innovation, Tour Prisma, 4/6 avenue d'Alsace, F-92982 Paris la Défense (FR).

(81) États désignés (sauf indication contraire, pour tout titre de protection nationale disponible) : AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IR, IS, JP, KE, KG, KN, KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.

(84) États désignés (sauf indication contraire, pour tout titre de protection régionale disponible) : ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), eurasien (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), européen (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV,

[Suite sur la page suivante]

(54) Title : PROCESS FOR MANUFACTURING A COMPOSITE STRUCTURE

(54) Titre : PROCEDE DE FABRICATION D'UNE STRUCTURE COMPOSITE

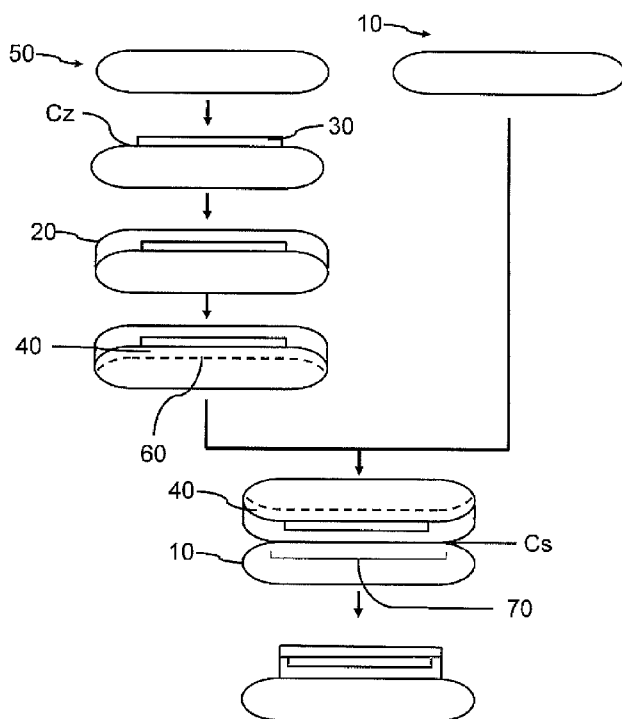


Fig 4a

(57) Abstract : The invention relates to a process for manufacturing a composite structure, said process comprising the following steps: a) providing a donor substrate (50) and a carrier substrate (10); b) forming a dielectric layer (30); c) forming a covering layer (20); d) forming a weakened zone (60) in the donor substrate (50); e) joining the carrier substrate (10) and the donor substrate (50) via a contact surface (70) having an outline (Cs); f) fracturing the donor substrate (50) via the weakened zone (60), steps b) and e) being executed so that the outline (Cz) is inscribed in the outline (Cs), and step c) being executed so that the covering layer (20) covers the peripheral surface of the dielectric layer (30).

(57) Abrégé : L'invention concerne un procédé de fabrication d'une structure composite, 5 ledit procédé comprenant les étapes suivantes: a) fournir un substrat donneur (50) et un substrat support (10); b) former une couche diélectrique (30); c) former une couche de recouvrement (20); d) former une zone de fragilisation (60) dans le substrat donneur (50); 10 e) assembler le substrat support (10) et le substrat donneur (50) selon une surface contact (70) présentant un contour (Cs); f) fracturer le substrat donneur (50) suivant

[Suite sur la page suivante]



MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, **Publiée :**
SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, — *avec rapport de recherche internationale (Art. 21(3))*
GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

la zone de fragilisation (60), les étapes b) et e) sont exécutées de sorte que le contour (Cz) soit inscrit dans le contour (Cs), et l'étape c) est exécutée de sorte que la couche de 15 recouvrement (20) recouvre la surface périphérique de la couche diélectrique (30).